



CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

一种P-n透明同质结二极管及其制备方法

文献类型: 专利

作者 王焕华¹; 杨铁莹; 姜晓明¹; 贾全杰¹; 秦秀波¹; 于润升¹; 王宝义¹

发表日期 2009-07-22

专利号 CN101964381A

公开日期 2011-02-02

源URL [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/210997]

专题 高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 王焕华,杨铁莹,姜晓明,等. 一种P-n透明同质结二极管及其制备方法. CN101964381A. 2009-07-22.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

7

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。